






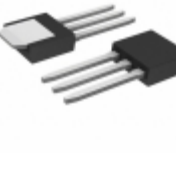



	<h2 style="color: red;">GP1M007A065CG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M007A065CG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M007A065CG.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2641 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Artikelnummer	<a href="#">GP1M007A065CG</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2641 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3.25A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1201pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>GP1M008A025FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M006A065F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M006A065FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK</p>
 <p><b>GP1M006A065PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A070F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M006A070FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M007A090FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220F</p>

### GP1M007A065CG Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Global Power Technologies Group	<a href="#">GP1M007A065CG Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M007A065CG-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M007A065CG PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M007A065CG</a>
<a href="#">GP1M007A065CG Electronic</a>	<a href="#">GP1M007A065CG-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M007A065CG-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M007A065CG-Bild</a>	<a href="#">GP1M007A065CG-Teil</a>
<a href="#">GP1M007A065CG Preis</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Hersteller</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Bild</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Aktie</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Inventar</a>
<a href="#">GP1M007A065CG Neu</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Original</a>	<a href="#">GP1M007A065CG garantiert</a>	<a href="#">GP1M007A065CG RFQ</a>	<a href="#">GP1M007A065CG Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited